

固体辐射物理研究室知识库

ALL

精确检索请加双引号



Go



首页

研究单元&专题

作者

文献类型

学科分类

知识图谱

新闻&公告

XJIPC OpenIR

> 固体辐射物理研究室



一种基于通道分离的大面阵彩色CMOS图像传感器辐照后暗电流评估方法



冯婕; 李豫东; 文林; 周东; 郭旗



2022-03-25

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

授权日期

2022-03-25

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及一种基于通道分离的大面阵彩色CMOS图像传感器辐照后暗电流评估方法,该方法涉及装置是由静电试验平台、三维样品调整台、样品测试板、大面阵彩色CMOS图像传感器样品、直流电源和计算机组成,在暗场条件下,选定积分时间,利用经过辐照后的图像传感器获取暗场图像并保存,根据坐标将图像传感器不同像素单元的相应数据归类放入R、GB、GR或B通道的灰度值矩阵中,再改变积分时间,最后画出暗场下各通道的曲线,该曲线拟合直线的斜率除以图像传感器的转换增益即分别为各通道的暗电流。本发明操作方便简单,可以直观的看出辐照引起器件各通道暗电流退化的情况。从而为大面阵彩色CMOS图像传感器在空间应用时的抗辐射设计提供理论依据和技术支撑。

申请日期

2020-05-09

申请号

CN202010385562.8

公开(公告)号

111541853B

代理机构

乌鲁木齐中科新兴专利事务所(普通合伙) 65106

文献类型

专利

条目标识符

http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/8595

专题

固体辐射物理研究室

推荐引用方式

冯婕,李豫东,文林,等. 一种基于通道分离的大面阵彩色CMOS图像传感器辐照后暗电流评估方法. 111541853B[P]. 2022-03-25. GB/T 7714

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

查看访问统计

导出为Endnote文件

谷歌学术

谷歌学术中相似的文章

[冯婕]的文章

[李豫东]的文章

[文林]的文章

百度学术

百度学术中相似的文章

[冯婕]的文章

[李豫东]的文章

[文林]的文章

必应学术

必应学术中相似的文章

[冯婕]的文章

[李豫东]的文章

[文林]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

